

插装系列温补晶体振荡器

产品特性:

- 典型DIP14/DIP8封装
- 宽温度范围可达到105℃
- LVCMOS/ Sine Wave 输出
- 高稳定度
- 频率范围宽 5MHz~170MHz
- 可定制

应用范围:

- 基站
- 三级钟
- 家庭基站
- 大规模设备



技术规范

初始频率准确度	$\leq \pm 1.5\text{ppm}$	
频率稳定度 Vs. 负载 $\pm 10\%$	$\leq \pm 0.2\text{ppm}$	
频率稳定度 Vs. VCC $\pm 5\%$	$\leq \pm 0.2\text{ppm}$	
老化 @25℃	$\leq \pm 1.0\text{ppm}$	
电源电流	10~26MHz	$\leq 10\text{mA}$
	26~60MHz	$\leq 20\text{mA}$
	60~100MHz	$\leq 30\text{mA}$
	100~170MHz	$\leq 50\text{mA}$
相位噪声	-135dBc/Hz@1KHz(以100MHz为例)	
开机时间	$\leq 5\text{mS}$	
输出	LVC MOS	Sine Wave
	负载	15 pF
	电平	VOH $\geq 0.9V_{CC}$ VOL $\leq 0.1V_{CC}$ 0~10dBm

表 1

工作温度范围		频率温度稳定度	
A	0℃~70℃	17	$\pm 0.1\text{ppm}$
B	-20℃~70℃	37	$\pm 0.28\text{ppm}$
C	-40℃~85℃	57	$\pm 0.5\text{ppm}$
D	-30℃~85℃	16	$\pm 1\text{ppm}$
E	-40℃~105℃	26	$\pm 2.5\text{ppm}$
F	-55℃~95℃		
G	定制		

订货指南

TCXO

封装 (表 2)

输出类型 (表 2)

电源电压 (表 2)

工作温度范围 (表 1)

频率温度稳定度 (表 1)

压控特性 (表 2)

频率可定制

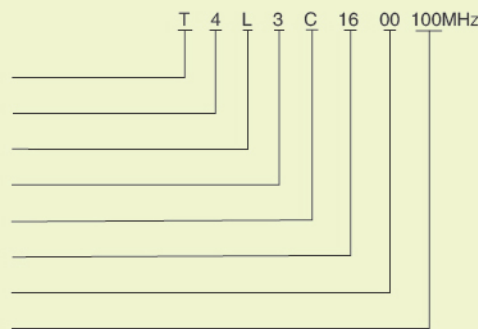


表 2

封装	输出类型	电源电压	
4 DIP14	L LVCMOS	3	3.3V
8 DIP8	S Sine Wave	5	5.0V

压控特性	
00	无压控
06	$\pm 3\text{ppm}$
10	$\pm 5\text{ppm}$
20	$\pm 10\text{ppm}$

注: 封装尺寸及引脚功能详见 21~25

温补晶体振荡器

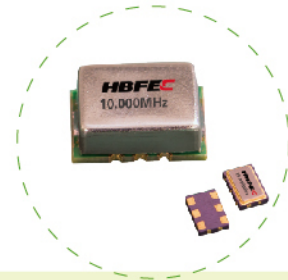
贴片系列温补晶体振荡器

产品特性:

- 典型 SMD 陶瓷封装
- 低电压工作
- LVCMOS/Clipped Sine Wave 输出
- 高稳定度
- 频率范围: 10MHz~60MHz

应用范围:

- GPS
- WiMAX/WLAN
- 移动电话
- 无线连接
- 智能电网



技术规范

初始频率准确度	≤ ± 1.5ppm		
频率稳定度 vs. 负载 ± 10%	≤ ± 0.2ppm		
频率稳定度 vs. VCC ± 5%	≤ ± 0.2ppm		
老化 @25℃	≤ ± 1.0ppm		
电源电流	LVCMOS	10~26MHz	≤ 6mA
		26~60MHz	≤ 10mA
	Clipped Sine Wave	10~26MHz	≤ 1.5mA
		26~60MHz	≤ 2mA
相位噪声	-145dBc/Hz@1KHz (以10MHz为例)		
开机时间	≤ 5mS		
输出		LVCMOS	Clipped Sine Wave
	负载	15 pF	10KΩ//10pF
	电平	VOH ≥ 0.9V _{CC} VOL ≤ 0.1V _{CC}	0.8V _{P-P}

表 1

工作温度范围		频率温度稳定度	
A	0℃~70℃	17	± 0.1ppm
B	-20℃~70℃	37	± 0.28ppm
C	-40℃~85℃	57	± 0.5ppm
D	-30℃~85℃	16	± 1ppm
E	-40℃~105℃	26	± 2.5ppm
F	-55℃~95℃		
G	定制		

订货指南

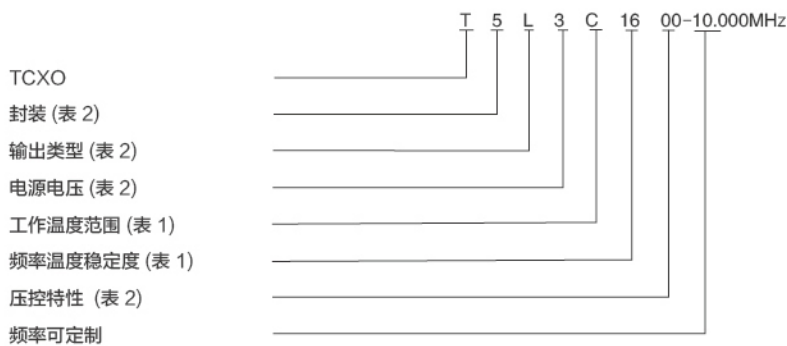


表 2

封装		输出类型	
2	2520	L	LVCMOS
3	3225	C	Clipped Sine Wave
5	5032		
7	7050		
9	9x14		

电源电压		压控特性	
1	1.8V	00	无压控
2	2.5V	06	± 3ppm
3	3.3V	10	± 5ppm
5	5.0V	20	± 10ppm

注: 封装尺寸及引脚功能详见 21~25.